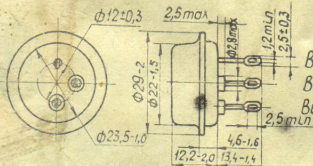




ПАСПОРТ

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПА: ГТ806А,
ГТ806В, ГТ806Б, ГТ806Г, ГТ806Д

Соответствуют техническим условиям
3.365.021 ТУ



Вывод коллектора
Вывод базы
Вывод эмиттера

Вес не более 28 г.

В одном приборе содержится 0,2680 мг золота и 21,8006 мг серебра.

1. Электрические параметры при $t_{amb} = +20 \pm 5^\circ\text{C}$

Тип прибора	Ток коллектора закрытого транзистора I_{CEV} при $U_{EB} = -1$ В и $U_{CEV} = -75$ В — ГТ806А $U_{CEV} = -100$ В — ГТ806Б $U_{CEV} = -120$ В — ГТ806В $U_{CEV} = -50$ В — ГТ806Г $U_{CEV} = -140$ В — ГТ806Д (мА)	Статистический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала на границе насыщения β_{31E} при $I_C = 10$ А		Обратный ток эмиттера I_{EBO} при $U_{EB} = -1,5$ В (мА)	Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме насыщения $U_{CE sat}$ при $I_C = 15$ А $I_B = 2$ А (В)	Напряжение между базой и эмиттером в режиме насыщения $U_{BE sat}$ при $I_C = 15$ А $I_B = 2$ А (В)
		не менее	не более			
ГТ806А	15	10	100	8	0,6	1
ГТ806Б	15	10	100	8	0,6	1
ГТ806В	15	10	100	8	0,6	1
ГТ806Г	15	10	100	8	0,6	1
ГТ806Д	15	10	100	8	0,6	1

2. Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Нормы параметра				
		ГТ806А	ГТ806Б	ГТ806В	ГТ806Г	ГТ806Д
Максимально допустимое напряжение между коллектором и эмиттером закрытого транзистора при $t_{case} = \text{минус } 55^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$, В	$U_{CEV max}$	-75	-100	-120	-50	-140
Максимально допустимое напряжение между эмиттером и базой при $t_{case} = \text{минус } 55^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$, В	$U_{EB max}$	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Максимально допустимый ток коллектора в режиме насыщения при $t_{case} = \text{минус } 55^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$, А	$I_C sat max$	15	15	15	15	15
Максимально допустимый ток базы при $t_{case} = \text{минус } 55^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$, А	$I_B max$	3	3	3	3	3
Максимально допустимая мощность на коллекторе при t_{case} до $+25^\circ\text{C}$, Вт	$P_C max$	30	30	30	30	30
Максимально допустимая мощность на коллекторе без теплоотвода при t_{amb} до $+25^\circ\text{C}$, Вт	$P_C max$	2	2	2	2	2
Максимально допустимая температура перехода, $^\circ\text{C}$	$t_j max$	85	85	85	85	85
Тепловое сопротивление (переход—корпус), $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	R_{thjc}	2	2	2	2	2
Предельно допустимая температура корпуса, $^\circ\text{C}$	$t_{case min}$	-55	-55	-55	-55	-55
	$t_{case max}$	+55	+55	+55	+55	+55

Примечание. При температуре корпуса выше 25°C предельная величина мощности подсчитывается по формуле:

$$P_{C max} = \frac{85^\circ\text{C} - t_{case}^\circ\text{C}}{2^\circ\text{C}/\text{Вт}} \text{ (Вт)}$$

8. Условия хранения приборов

Складские условия:

- температура окружающего воздуха от +5°C до +35°C;
- относительная влажность до 85%;
- отсутствие в воздухе кислотных и других агрессивных примесей.

Полевые условия:

- температура окружающего воздуха может изменяться в пределах от -40°C до +40°C;
- относительная влажность до 98% при температуре +30°C.

4. Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приборов всем требованиям ТУ в течение шести лет для приборов в аппаратуре и ЗИП, в том числе 10000 часов эксплуатации в течение этого срока; шести лет для приборов, хранящихся в складских условиях в упаковке поставщика.

5. Указания и рекомендации по эксплуатации

1. При пайке должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора. Температура пайки не должна превышать $280^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$.

— Допускается производить соединение выводов с элементами схемы на расстоянии не менее 6 мм от корпуса транзистора любым способом (пайка, сварка и т. п.) при условии соблюдения следующих требований:

— за все время соединения температура в любой точке корпуса транзистора не должна превышать максимально допустимую по ТУ температуру окружающей среды.

2. Изгиб выводов при монтаже не допускается.

3. При эксплуатации транзисторов в условиях ускорений более 2 g транзисторы необходимо крепить за корпус.

4. При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен присоединяться последним и отключаться первым.

5. В процессе работы не разрешается превосходить максимально допустимые значения токов, напряжений и мощности во всем интервале температур.

Для обеспечения надежной работы транзистора не реко-

мендуются совмещения нескольких предельно допустимых режимов.

6. Во избежание выхода из строя транзистора не допускается отключение цепи базы при наличии напряжения между коллектором и эмиттером.

— Запрещается использование транзисторов, у которых цепь базы разомкнута по постоянному току.

7. Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во всем диапазоне температур.

Штамп ОТК

6. Рекламации

В случае преждевременного выхода транзистора из строя данный прибор возвратителю предприятию-изготовителю с указанным следующими данными:

Время хранения _____
(заполняется, если прибор

не был в эксплуатации)

Общее число часов работы прибора _____

Основные данные режима эксплуатации _____

(причина снятия прибора с эксплуатации или

хранения, количество приборов данного типа,

работавших в аналогичных условиях, по не

отказавших, и общее число часов работы их)

Сведения заполнил _____

ВНИМАНИЕ!

По окончании эксплуатации прибора (если прибор снят с эксплуатации после истечения срока гарантированной наработки) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 6.